

概述

74HC595D是一款高速 CMOS 8 位串行移位寄存器,带有存储寄存器和低电平及高阻输出。移位寄存器和存储寄存器分别采用单独的时钟。在 SCK 的上升沿,数据发生移位,而在 RCK 的高电平时间内,数据从每个寄存器中传送到存储寄存器。

移位寄存器带有一个串行输入(SER)端和一个串行标准输出(Q7')端,用于级联。74HC595D存储寄存器带有8个总线驱动输出,数据输出方式为低电平及高阻态。

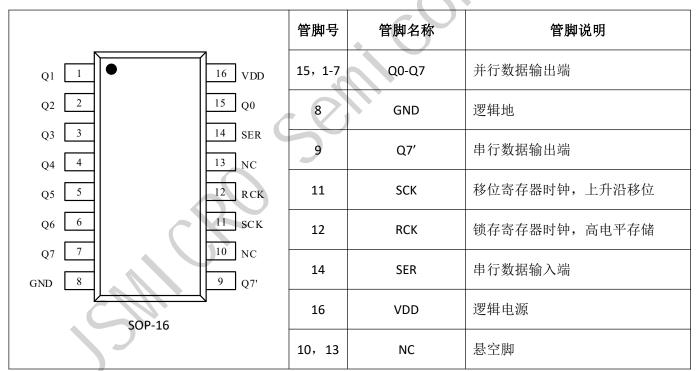
特点

- ➤ 采用 CMOS 工艺。
- ➤ 工作电压范围: 3.0-5.0V。
- ▶ 高速移位时钟频率 Fmax>25MHz。
- ▶ 串行输出可用于多个设备的级联。
- ▶ 封装形式: SOP-16。

产品应用

▶ P10 恒压 LED 单色显示屏。

管脚定义及说明

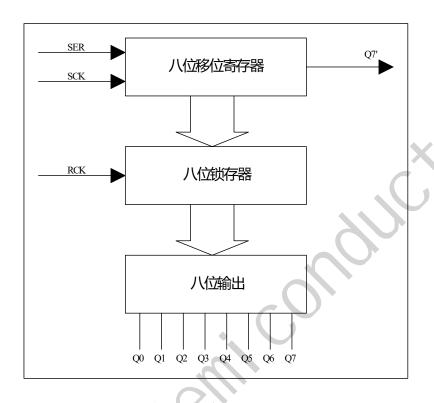


功能真值表

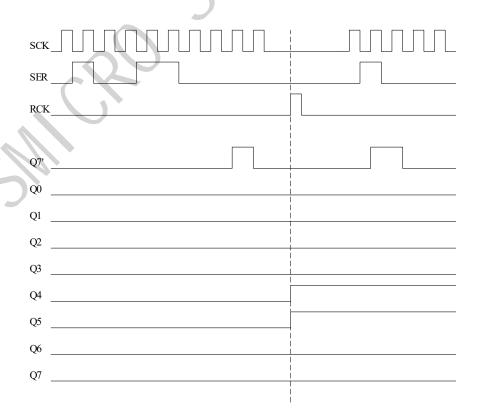
RCK	SCK	功能
X	†	移位寄存器存储,Qn=Qn-1
Н	X	存储移位寄存器的值



逻辑图



工作时序图





直流电气参数

极限参数(Ta=25℃)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~ +7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ~ VDD+0.5	V
功率损耗	PD	<400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +85	${\mathcal C}$
储存温度	Tstg	-50 ~ +150	°C

正常工作范围(Ta=-20~+80℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
逻辑电源电压	VDD		3.0	5.0	5.5	V
高电平输入电压	V _{IH}	VDD=5.0V	3.2	<u></u>		V
低电平输入电压	V _{IL}	VDD=5.0V			1.8	V

直流特性

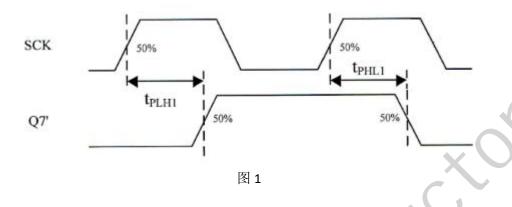
110101411						
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
高电平输出电压	V _{OH}	VDD=5.0V	4.9			V
低电平输出电压	V _{OL}	VDD=5.0V			0.1	V
静态电流损耗	I _{DD}	VDD=6.0V			1	uA
Q0~Q7 输出端口驱动电流	I _{OL}	VDD=5.0V	63		75	mA
Q7′端口驱动电流	I _{OH7}	VDD=5.0V	-20		-32	mA
	I _{OL7}	VDD=5.0V	20		32	mA

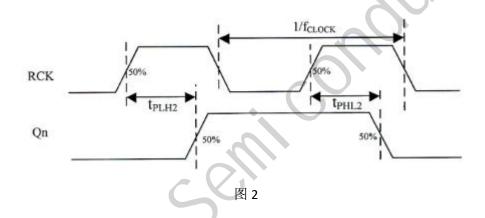
交流特性

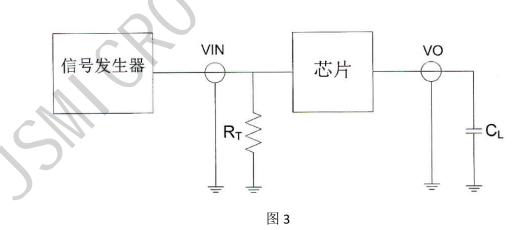
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
最大时钟频率	f _{CLOCK}			-	30	MHz
SCK→Q7′输出上升延时	t _{PLH1}			22		ns
SCK→Q7′输出下降延时	t _{PHL1}	VDD=5.0V, CL=15pF 时序图如图 1、图 2、		22		ns
RCK→Qn 输出上升延时	t _{PLH2}	测试电路图如图 3		10		ns
RCK→Qn 输出下降延时	t _{PHL2}	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		10		ns



交流特性波形图





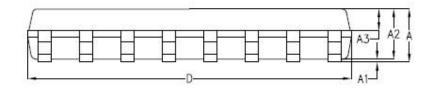


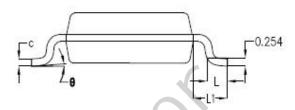
注:RT为信号发生器匹配电阻。

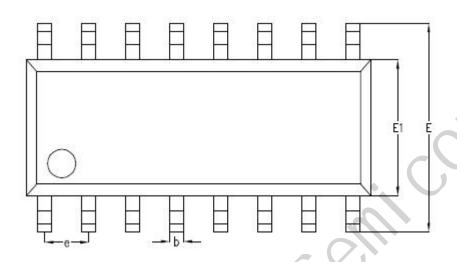


封装信息

➤ SOP-16







SYMBOL	MILLIMETER				
SIMDUL	MIN	NOM	MAX		
A	\ \ \	1.61	1.66		
A1	- -	0.10	0. 25		
A2	1. 47	1.52	1. 57		
A3	0.61	0.66	0.71		
b	0.35	0.40	0.45		
c	0.17	0.22	0. 25		
D	9.80 9.90		10.0		
Е	5. 90	6.00	6. 10		
E1	3.80	3.90	4.00		
е	1. 27BSC				
L	0.60	0.65	0.70		
L1	1. 05BSC				
θ	0°	4°	6°		